

平成 27 年 8 月 4 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 145 回研究会 開催通知

日時： 2015 年 10 月 2 日 (金), 13:00-17:25

会場： 明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン A4 会議室

http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html

東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL: 03-3296-4545 明治大学総合案内)

交通： JR 中央線・総武線, 東京メトロ丸の内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分

東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分

都営地下鉄三田線・新宿線, 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ：「シリコンフォーラム, パワデバ Si 研究会他の注目発表」

世話人：金田 寛 (九州工業大学), 村上 進 (茨城大学), 末岡 浩治 (岡山県立大学), 山下 善文 (岡山大学)

プログラム：

- | | | | | |
|------|-------------|---|-------------------------|-------|
| (1) | 13:00-13:05 | 開会の挨拶 | 明治大学 | 田島 道夫 |
| (2) | 13:05-13:10 | はじめに | 九州工業大学 | 金田 寛 |
| (3) | 13:10-13:45 | 「高濃度不純物添加 Si および Ge 結晶成長における組成的過冷却現象の評価・解析」 | 信州大学 | 太子 敏則 |
| (4) | 13:45-14:20 | 「CZシリコン結晶成長時の点欠陥発生に与える内部応力とドーパントの効果」 | 岡山県立大学 | 末岡 浩治 |
| (5) | 14:20-14:55 | 「超高温 RTO による Cz-Si 結晶の酸素析出核制御」 | グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 | 荒木 浩司 |
| | 14:55-15:15 | ・・・・ 休憩・・・・ | | |
| (6) | 15:15-15:50 | 「炭素クラスターイオン照射による Si ウェーハの近接ゲッターリング技術-CMOS イメージセンサのデバイス特性にクラスター照射が与える効果」 | 株式会社 SUMCO | 栗田 一成 |
| (7) | 15:50-16:25 | 「Si パワーデバイスのキャリアライフタイム制御の安定性における微量残留元素の影響：ウエハ母材依存性(エピ, FZ, MCZ)」 | 三菱電機株式会社 | 湊 忠玄 |
| (8) | 16:25-17:00 | 「電子線照射発光活性化による Si 中の微量炭素分析」 | グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 | 中川 聡子 |
| (9) | 17:00-17:20 | 全体討論：共通理解を求めて。(進行役) | 九州工業大学 | 金田 寛 |
| (10) | 17:20-17:25 | おわりに | 茨城大学 | 村上 進 |
| | 17:30- | 懇親会 | 宮城浩蔵ホール (リバティータワー 23 階) | |